

Advance Materials Corporation

TEL 03-431-5168 Ext: 7202

FAX 03-431-6868

桃園縣楊梅鎮中山北路二段 256 巷 168 號

技術資料

LPR-600F

簡介

聯致科技公司所製造之LPR-600F為綠色、負型、UV感光液態光阻劑,適用於滾輪塗佈(Roller coating),所塗佈之光阻劑膜面良好、無缺陷,可提供製造高精密度之印刷電路板。LPR-600F適用於酸性條件下做蝕刻操作,

特色

- 1. 所塗佈之光阻劑膜面良好,無針孔。
- 2. 優異的再現性。
- 3. 乾燥時間短,可加速生產量。
- 4. 曝光能量低,解像力佳,良好的填覆性與密著力。
- 5. 曝光後顏色變深,且曝光前後色差變化大,方便於線路檢查。
- 6. 容易顯像、容易去膜。
- 7. 耐藥品性佳。
- 8. 疊板能力佳。
- 9. 低臭味。

組		成		物	酸性高分子,光起始劑,反應性單體,染料、助劑等。 溶劑:Propylene glycol monomethyl ether acetate (PMA:bp 146℃)				
黏	度	稀	釋	劑	Propylene glycol monomethyl ether acetate				
黏				度	3800~4100 cps /25℃ (cone plate E 型黏度計)				
固		含		量	LPR-600 : 50±3 wt%				
外				觀	綠色				
氣				味	酯類溶劑之芳香性氣味				
比				重	≒ 1.05				
水	中	溶	解	度	≦50% (水溶性成份含有量)				
					請儲存於溫度 5~22℃,濕度 50~60%RH,陰涼乾燥環境,避免陽光				
					直射; 在 22℃下可保存 12 月以上。請在 UV-free 黃光下開罐使用,				
儲	存與	使	用注	意	不使用時應緊閉罐口。避免直接接觸皮膚,若不慎接觸皮膚應以肥皂				
事				項	水與清水沖洗。如仍有刺激或過敏反應請送醫治療。如使用時不慎將				
					光阻劑撒出致污染地面或機台器具,可用有機溶劑(如 Acetone、				
					MEK、PMA、DPM 等)擦拭清除。				
閃		火		點	42.2℃				

製程條件

前處理 化學微蝕($3\sim6\%$ H_2SO_4 ;temp.: $30\sim40^{\circ}$ C; pressure:2.0 kg/cm²) (Pre-treatment)微蝕建議量:0.3-1.0 microns

最後水洗段水質最好為去離子水(D.I. water),以確定板面沒有鹽類殘留。適當的水洗和烘乾可避免水痕殘留於板面上。

*光阻塗佈前,需先檢查銅面是否有油污、氧化、灰塵異物,若板面 上有異物污染,容易影響油墨的平坦、密著力。可依水破試驗:30 秒以上水膜不破為合格。

塗佈 滾輪塗佈機(Vertical roller coating machine)

(Coating) 塗佈速率: 2-10 m/min(塗佈速率應與乾燥段線速達成平衡)

Roller type V-Groove(Pitch=300-500um,

Depth=150-300microns)

Ex.

Pitch=320,Depth=186microns(Dry:8-10microns)

Pitch=380,Depth=220microns(Dry:10-12microns)

建議塗佈膜厚 濕膜:30-35microns, 乾膜:9-11microns *塗佈和烘乾區應維持在 Class 1,000 無塵室環境或更佳潔淨度

乾燥 熱風烘箱

(Drying) 乾燥條件: 80-120°C, 6-12minutes

Ex. 4 段熱風烘箱: 120-115-110-100℃,7min

*烘乾條件應視不同的烘箱而定

*LPR-600V 具有寬廣的乾燥操作條件

曝光 曝光能量: 50-80 mJ/cm² (Mylar 下的能量)

(Exposure) 建議曝光格數:6-8格(Stouffer 21-Step)

光阻解析能力: L/S=2/2(mil) 最低曝光強度: 10mW/cm²

*較低的曝光能量可能引起斷路或缺口等缺陷

顯影 顯影溫度:28-32℃,1wt%Na₂CO₃ 或 K₂CO₃, 噴壓:1.0-2.0Kg/cm²

(Development) 顯影時間:48-55 秒 pH:10.6-11.4(顯破點:15-20 秒,33%-45%槽長)

需要時可適度添加消泡劑;更換槽液時間:光阻劑負荷量>5g/L

水洗 20-30℃,水洗噴壓:1-3Kg/cm²,水洗時間:30-60 秒

(Rinsing) 水洗槽長度最少要有顯影槽一半長度,最好為顯影槽長的1或1.5

倍。

*水洗不足時,易造成銅渣

蝕刻 45-55℃ CuCl₂ or FeCl₃

(Etching) 氧化還原電位 ORP: 500-560mV

溫度:40-50℃

銅離子含量:155-185g/L

HCl 濃度:1-3 N 比重:1.24-1.45

*實際條件依不同客戶有所不同

剝膜 40-55℃,2-3%NaOH, 60-90 秒(Break point: 10-15 秒)

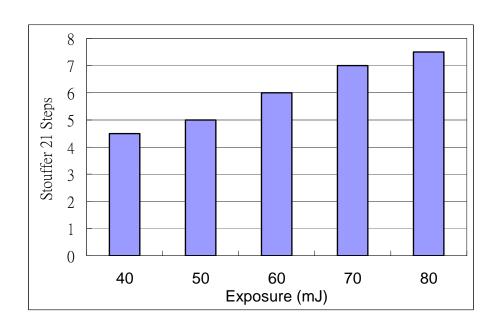
(Stripping) 噴壓:1.5-2Kg/cm²

*剝膜後膜大小: 0.5-1cm 碎片

曝光能量與感度關係

曝光 ORC HMW7KW(Metal halide lamp, 7KW, Dispersed light) Energy measurement (Under the mylar measured by UV-350) Stouffer 21 step tablet

顯影 1%Na2CO3,噴壓:2.0Kg/cm2



預烤寬容度

熱風烤箱

	5min	7min	9min	11min
80°C	\triangle	0	0	0
90°C 100°C	0	0	0	0
100°C	0	0	0	0
110℃	0	0	0	0
120°C	0	0	0	0

△ : 乾燥不足○ : 乾燥 OK

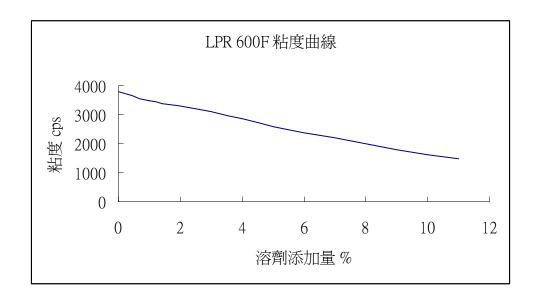
操作注意事項

前處理: 液態光阻的塗佈過程,對於銅面上的水漬、油污非常敏感。前處理完 的銅面需要仔細是否乾燥完全,確保沒有水分,避免影響油墨對銅面 的密著力。傳送輪上若有異物,會污染銅面影響光阻的密著力。

疊板: 乾燥後的基板以水平方式堆疊,以 20Kg 重物壓,在<25℃、<65%RH 環境下,可堆放 2 天無黏板現象。板子需存放於黃光或 UV-free 環境下,若放置於含紫外光燈源下,溶液造成顯影不良。

曝光: 曝光機真空壓力及吸真空時間應足夠,避免底片與光阻密合度不足(吸 氣不良);若是吸氣不良會造成短路、斷路及缺口等缺陷。 通常液態光阻的解析度比乾膜光阻來得好,但也因此液態光阻受底片 污染及缺陷影響比乾膜來得更明顯;所以曝光斷的清潔特別加強注意。

塗佈 塗佈時可依機台條件及狀況調整粘度,較佳的粘度粘度可獲得更佳膜 厚均勻度,



- 1. 本產品為高度光感性油墨,請避免直接日照。
- 2. 油墨存放條件: 5-25°C、50-60%RH 陰涼環境下儲存。
- 3. 避免與酸、鹼、氧化劑及胺類接觸。
- 4. 勿近火源。
- 5. 使用時請穿戴手套、護目鏡、防護衣等保護器具,注意勿接觸皮膚,若不慎接觸皮膚,應以肥皂及大量清水沖洗(至少15分鐘),如仍有刺激或過敏反應請送醫治療。
- 6. 作業場所請裝設排氣裝置。